



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Höchstzulässige Werte / Maximum rated values

Vorläufige Daten

Preliminary Data

Periodische Vorwärts- und Rückwärts-Spitzensperrspannung repetitive peak forward off-state and reverse voltages	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{DRM}}, V_{\text{RRM}}$	1600, 1800 2000, 2200	V
Vorwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak forward off-state voltage	$T_{vj} = -40^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	V_{DSM}	1600, 1800 2000, 2200	V
Rückwärts-Stoßspitzensperrspannung non-repetitive peak reverse voltage	$T_{vj} = +25^{\circ}\text{C} \dots T_{vj\text{max}}$	V_{RSM}	1700, 1900 2100, 2300	V
Durchlaßstrom-Grenzeffektivwert RMSM on-state current		I_{TRSM}	5800	A
Dauergrenzstrom average on-state current	$T_{\text{C}} = 85^{\circ}\text{C}$ $T_{\text{C}} = 61^{\circ}\text{C}$	I_{TAVM}	2710 3700	A A
Stoßstrom-Grenzwert surge current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	I_{TSM}	54000 50000	A A
Grenzlastintegral I^2t -value	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, t_p = 10\text{ms}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, t_p = 10\text{ms}$	I^2t	14580 12500	$\text{A}^2\text{s} \cdot 10^3$ $\text{A}^2\text{s} \cdot 10^3$
Kritische Stromsteilheit critical rate of rise of on-state current	DIN IEC 747-6 $f=50\text{Hz}, v_L = 10\text{V}, i_{\text{GM}} = 1\text{A}$ $di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	$(di_{\text{T}}/dt)_{\text{cr}}$	200	$\text{A}/\mu\text{s}$
Kritische Spannungssteilheit critical rate of rise of off-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, V_{\text{D}} = 0,67 V_{\text{DRM}}$ 5.Kennbuchstabe / 5th letter F	$(dv_{\text{D}}/dt)_{\text{cr}}$	1000	$\text{V}/\mu\text{s}$

Charakteristische Werte / Characteristic values

Durchlaßspannung on-state voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_{\text{T}} = 11000\text{A}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, i_{\text{T}} = 3000\text{A}$	v_{T}	max. 2,35 max. 1,30	V V
Schleusenspannung threshold voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	$V_{\text{T(TO)}}$	0,9	V
Ersatzwiderstand slope resistance	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	r_{T}	0,125	$\text{m}\Omega$
Durchlaßkennlinie on-state voltage $v_{\text{T}} = A + B \times i_{\text{T}} + C \times \ln(i_{\text{T}} + 1) + D \times \sqrt{i_{\text{T}}}$	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$	A=1,09532 B=8,255E-05 C=-7,06279E-02 D=9,53181E-03		
Zündstrom gate trigger current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$	I_{GT}	max. 300	mA
Zündspannung gate trigger voltage	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$	V_{GT}	max. 2,5	V
Nicht zündener Steuerstrom gate non-trigger current	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 6\text{V}$ $T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	I_{GD}	max. 10 max. 5	mA mA
Nicht zündene Steuerspannung gate non-trigger voltage	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}, v_{\text{D}} = 0,5 V_{\text{DRM}}$	V_{GD}	max. 0,25	mV
Haltestrom holding current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{A}} = 5\Omega$	I_{H}	max. 300	mA
Einraststrom latching current	$T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}, v_{\text{D}} = 6\text{V}, R_{\text{GK}} \geq 10\Omega$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$ $t_{\text{g}} = 20\mu\text{s}$	I_{L}	max. 1500	mA
Vorwärts- und Rückwärts-Sperrstrom forward off-state and reverse currents	$T_{vj} = T_{vj\text{max}}$ $v_{\text{D}} = V_{\text{DRM}}, v_{\text{R}} = V_{\text{RRM}}$	$i_{\text{D}}, i_{\text{R}}$	max. 250	mA
Zündverzug gate controlled delay time	DIN IEC 747-6 $T_{vj} = 25^{\circ}\text{C}$ $i_{\text{GM}} = 1\text{A}, di_{\text{G}}/dt = 1\text{A}/\mu\text{s}$	t_{gd}	max. 4	μs

Technische Information / Technical Information

eupec

Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor

T 2706N 16 ... 22

N



Elektrische Eigenschaften / Electrical properties

Charakteristische Werte / Characteristic values

Vorläufige Daten

Preliminary Data

Freiwerdezeit circuit commutated turn-off time	$T_{vj} = T_{vj\ max}$, $i_{TM} = I_{TAVM}$ $V_{RM} = 100V$, $V_{DM} = 0,67 V_{DRM}$ $dv_T/dt = 20 V/\mu s$, $-di_T/dt = 10 A/\mu s$ 4. Kennbuchstabe / 4th letter O	t_q	typ.	300	μs
---	--	-------	------	-----	---------

Thermische Eigenschaften / Thermal properties

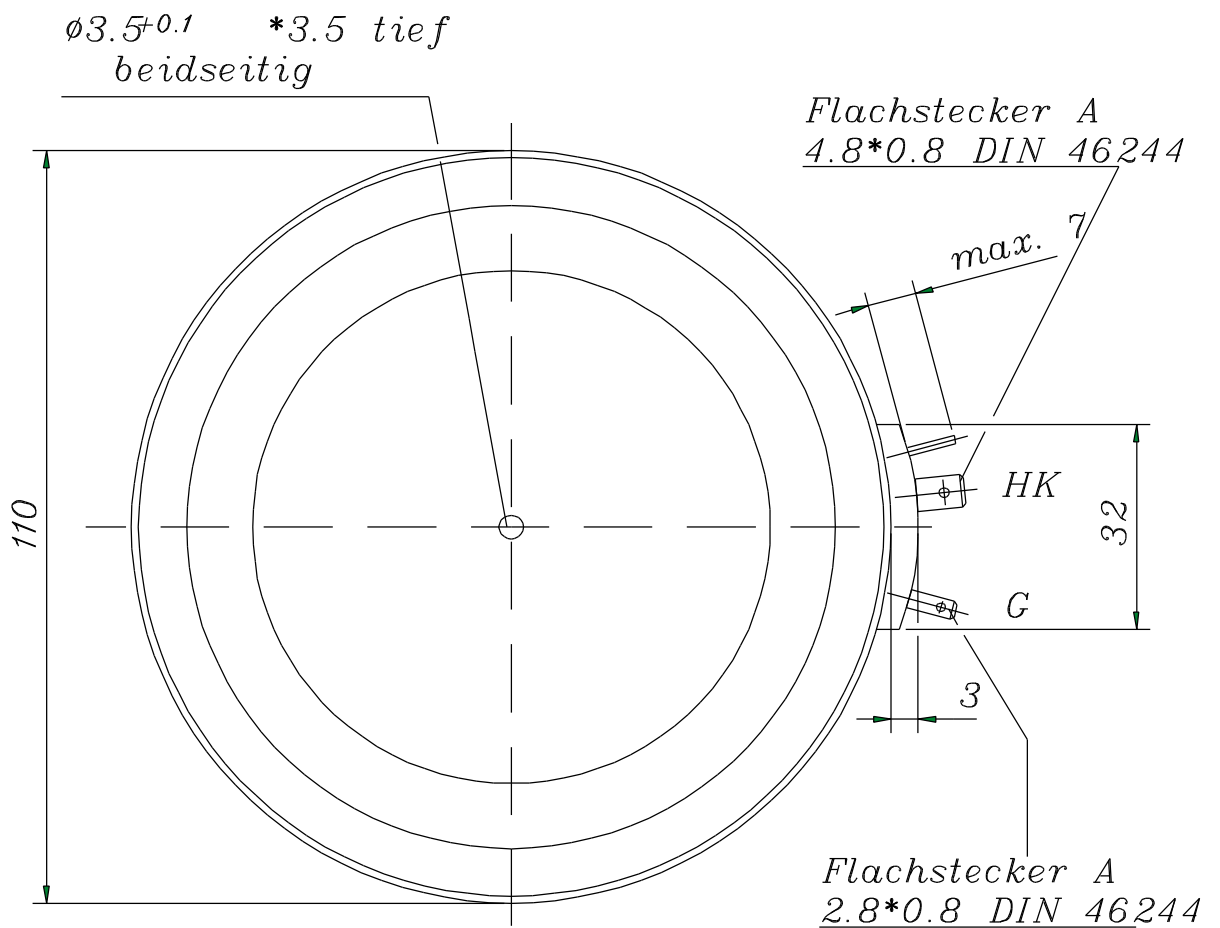
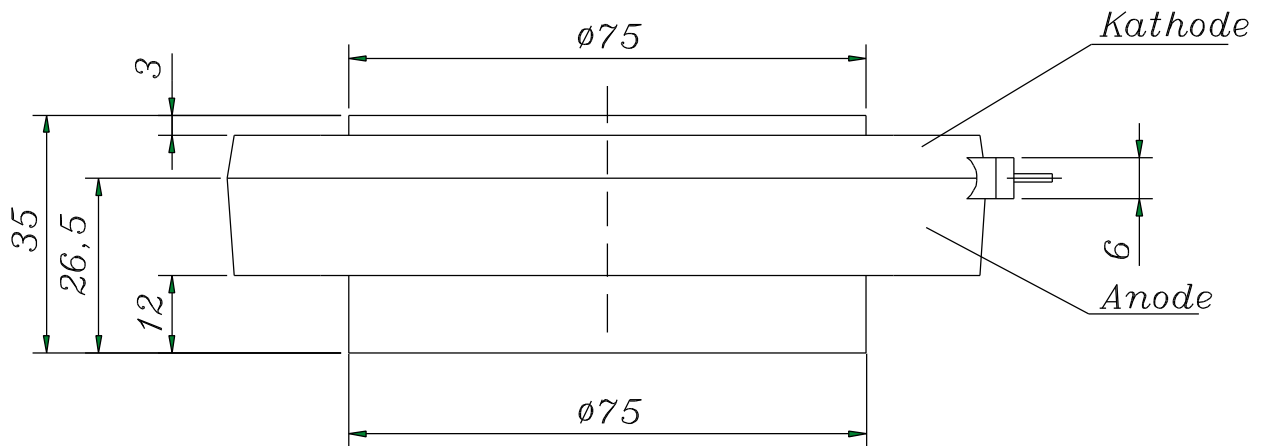
Innerer Wärmewiderstand thermal resistance, junction to case	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided, $\Theta = 180^\circ \sin$ beidseitig / two-sided, DC Anode / anode, $\Theta = 180^\circ \sin$ Anode / anode, DC Kathode / cathode, $\Theta = 180^\circ \sin$ Kathode / cathode, DC	R_{thJC}	max.	0,0085	$^\circ C/W$
			max.	0,0078	$^\circ C/W$
			max.	0,0152	$^\circ C/W$
			max.	0,0146	$^\circ C/W$
			max.	0,0183	$^\circ C/W$
			max.	0,0169	$^\circ C/W$
Übergangs- Wärmewiderstand thermal resistance, case to heatsink	Kühlfläche / cooling surface beidseitig / two-sided einseitig / single-sided	R_{thCK}	max.	0,0025	$^\circ C/W$
			max.	0,0050	$^\circ C/W$
Höchstzulässige Sperrschichttemperatur max. junction temperature		$T_{vj\ max}$		125	$^\circ C$
Betriebstemperatur operating temperature		$T_{c\ op}$		-40...125	$^\circ C$
Lagertemperatur storage temperature		T_{stg}		-40...150	$^\circ C$

Mechanische Eigenschaften / Mechanical properties

Gehäuse, siehe Anlage case, see appendix			Seite 3 page 3	
Si-Element mit Druckkontakt, Amplifying-Gate Si-pellet with pressure contact, amplifying gate				
Anpreßkraft clamping force		F	42...95	kN
Gewicht weight		G	typ. 1200	g
Kriechstrecke creepage distance			33	mm
Feuchteklasse humidity classification	DIN 40040		C	
Schwingfestigkeit vibration resistance	f = 50Hz		50	m/s ²

www.DataSheet.in

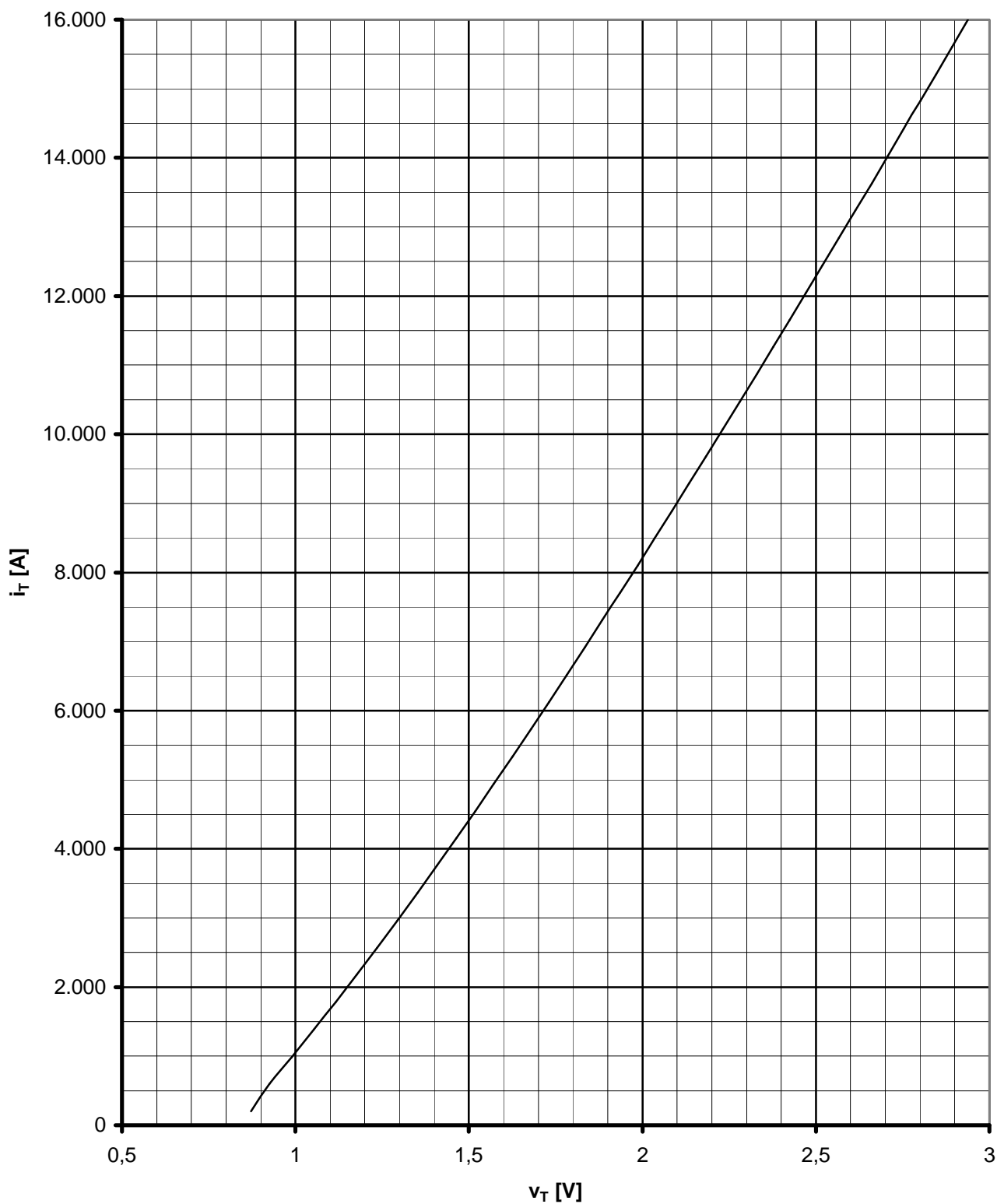
Mit dieser technischen Information werden Halbleiterbauelemente spezifiziert, jedoch keine Eigenschaften zugesichert. Sie gilt in Verbindung mit den zugehörigen Technischen Erläuterungen./ This technical information specifies semiconductor devices but promises no characteristics. It is valid in combination with the belonging technical notes.



Netz-Thyristor
Phase Control Thyristor

T 2706 N 16...22

N



Grenzdurchlaßkennlinie / Limiting On-state characteristic $i_T = f(v_T)$
 $T_{vj} = T_{vj} \text{ max}$



Kühlung cooling	Analytische Elemente des transienten Wärmewiderstandes Z_{thJC} für DC Analytical elements of transient thermal impedance Z_{thJC} for DC							
	Pos.n	1	2	3	4	5	6	7
beidseitig two-sided	R_{thn} [°C/W]	0,000030	0,00039	0,00123	0,0028	0,00338		
	τ_n [s]	0,000055	0,00392	0,0152	0,2068	1,0914		
anodenseitig anode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,000009	0,000371	0,0019	0,0013	0,00434	0,00668	
	τ_n [s]	0,000010	0,001820	0,00951	0,135	0,347	1,54	
kathodenseitig cathode-sided	R_{thn} [°C/W]	0,000032	0,000728	0,00302	0,00802	0,0051		
	τ_n [s]	0,000035	0,00341	0,0215	0,135	1,11		
<p>Analytische Funktion / analytical function : $Z_{thJC} = \sum_{n=1}^{n_{max}} R_{thn} (1 - EXP (- t / \tau_n))$</p>								